

Физический факультет МГУ
имени М.В. Ломоносова
Физико-Технический Институт
имени А.Ф. Иоффе РАН



11-я Всероссийская Конференция
«Нитриды галлия, индия и
алюминия: структуры и приборы»
Москва,
01-03 февраля 2017 г.

<http://nitrides-conf.ioffe.ru>

01-03 февраля 2017 г. в Москве, на физическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова, совместно с ФТИ имени А.Ф. Иоффе РАН, планируется проведение 11-й Всероссийской конференции «Нитриды галлия, индия и алюминия: структуры и приборы». Конференция продолжит традиции Рабочих Совещений (1997-2000 гг.) и Всероссийских Конференций (2001-2015 гг.), проводившихся поочередно в Москве и Санкт-Петербурге. Совещения и Конференции демонстрировали постоянно возрастающую активность в области III-N в России. В Конференции 2015г. приняли участие более 130 человек, представлявших 41 организацию. Было сделано 100 докладов, из них 56 устных.

Спонсорами предыдущих конференций были РФФИ, ОАО «Роснано», Aixtron AG, Veeco Instruments Inc., LayTec GmbH, CREE Inc., SemiLEDs Inc., ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника», «Прочип», ЗАО «НТО». Конференция будет проходить в форме устных и стендовых сессий. Официальный язык Конференции – русский. Доклады от зарубежных участников могут быть сделаны на английском языке. На Конференции будет организована выставка промышленных компаний.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ

1. Подложки для III-N эпитаксии.
2. Технология материалов: рост объёмных кристаллов.
3. Технология материалов: эпитаксиальные методы роста.
4. Оптические, электрические и структурные свойства материалов.
5. Свойства квантово-размерных структур на основе нитридов.
6. Конструкции, технологии и параметры приборов на основе нитридов.
7. Электронные и оптоэлектронные устройства на основе нитридов.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ДАТЫ

Предварительная регистрация:

Форма и правила заполнения приведены на сайте конференции, срок регистрации –
до 15 января 2017 г.

Тезисы докладов:

Объем тезисов доклада - 2 страницы (для приглашённых докладов - 4 страницы). Правила форматирования и образцы размещены на сайте конференции. Срок представления тезисов –
до 1 декабря 2016 г.

Финансовая поддержка участников:

Оргкомитет обратился в РФФИ и к возможным спонсорам («Роснано», «Росэлектроника», AIXTRON, VEECO, LayTec, «Светлана - Оптоэлектроника», «Научное и технологическое оборудование»).

Российские участники получают финансовую поддержку в зависимости от выделенных средств и сроков предварительной регистрации.

Организационный взнос

Размер оргвзноса - 4000 руб.

На сайте конференции будут размещаться текущие новости и объявления для участников. Просьба регулярно заходить на сайт.

<http://nitrides-conf.ioffe.ru>

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

А.А. Федянин (председатель) –	МГУ им. М.В. Ломоносова
П.С. Копьев (зам. председателя)	ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН
А.Н. Туркин (зам. председателя)	МГУ им. М.В. Ломоносова
В.В. Лундин (секретарь)	ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН
П.Ю. Боков (секретарь)	МГУ им. М.В. Ломоносова
В.Н. Данилин	ГУП «Пульсар»
А.Е. Николаев	ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН
Е.Е. Заварин	ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН
П.В. Боярков	«Новые технологии света»
М.В. Чукичев	МГУ им. М.В. Ломоносова
А.Е. Балакирев	«Прочип»
В.Е. Кудряшов	ГК «Российские нано-технологии»
В.Г. Терехов –	ООО «БЛ Трейд»
Е.Ю. Зыкова	МГУ им. М.В. Ломоносова
С.Н. Маркова –	МГУ им. М.В. Ломоносова

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

А.Э. Юнович (председатель)	МГУ им. М.В. Ломоносова
П.С. Копьев (зам. председателя)	ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН
А.В. Сахаров (секретарь)	ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН
С.В. Иванов	ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН
Л.М. Коган	НПЦ «Оптэл»
В.В. Лундин	ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН
А.А. Вилисов	Томский политехнический институт
К.С. Журавлёв	ИФП СО РАН
В.Г. Сидоров	СПбГПУ
С.Ю. Шаповал	ИПТМ РАН
С.Ю. Карпов	«Софт-Импакт»
Е.В. Луценко	ИФ НАН Беларуси
А.Ф. Цацульников	ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН
В.М. Устинов	ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН
П.А. Форш	МГУ им. М.В. Ломоносова
О.В. Снигирев	МГУ им. М.В. Ломоносова
Е.В. Каевицер	АО «НПП «Пульсар»
И.С. Васильевский	НИЯУ «МИФИ»
В.А. Сергеев	ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН